

Космометрия

(от веры к осознанию)

Часть вторая

Электромагнитные волны

© Иван Дмитриевич Станев 2014г.

Николаев, 54017, Украина

E-mail: dstanev@mail.ru

Аннотация

Целью данных теоретических исследований является выяснение сущности ЭМВ и фотона, а также механизма их излучения и распространения.

Оглавление:	
Глава 9 электромагнитные волны	2
9-1 Электромагнитные волны в свете Космометрии	2
9-2. Сравнительный анализ между волновыми эфирпотоками 3D и 2D пространств .	10
9.3 фотон.....	12
9-3 влияние Центральных полей на плотность пространства	19
Литература:	22

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

(см. [1])

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 9 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

Перед тем, как приступить к изложению своего виденья по данному вопросу напоминаю, что выше (см. [1] гл. 1), с целью удобства изложения и понимания материала, важнейшим объектам Вторичной Реальности были даны следующие условные названия:

- **Сам-Батэра** – «наша» трёхмерная вселенная;
- **Самбатэрпространство** – трёхмерное пространство Сам-Батэры;
- **Одис-Фея** – предыдущая по отношению к Сам-Батэре четырёхмерная вселенная;
- **Самбатэрсреда** – четырёхмерная пространствообразующая среда – объект Одис-Феи, на котором базируется Сам-Батэра;
- **Одисфейпространство** – четырёхмерное пространство Одис-Феи;
- **Стивда** – «наше» Мироздание, включающее в себя системное множество вселенных разных мерностей.

9-1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В СВЕТЕ КОСМОМЕТРИИ

Поскольку в этом разделе мы будем рассматривать только элементарные электромагнитные волны, т. е. электромагнитные волны, обусловленные развитием и аннигиляцией вэпса, то условимся далее под аббревиатурой «ЭМВ» подразумевать

«элементарные электромагнитные волны», а в других случаях приводить дополнительные пояснения.

Проанализируем динамику пространства в окрестности вэпса (см. [1], гл.3) обусловленной процессом его развития и аннигиляции (см. рис. 9.1).

К сформулированным в третьей главе (см. [1], раздел 3.2) геометрическим характеристикам вэпса добавим следующие два определения:

Определение 9-1. Лицевая биполярная порядкообразующая сфера (ЛБПС) вэпса $k^{-го}$ порядка – двумерная поверхность лицевого подпространства, образованная внешними порядкообразующими полусферами негалунки и позигорки $k^{-го}$ порядка и замыкающей их внутренней цилиндрической поверхностью, центральная ось которой совмещена с лицевой продольной осью вэпса (см. [1], опр. 1-9, 1-10, 1-11 и 3-42).

Определение 9-2. Теневая биполярная порядкообразующая сфера (ТБПС) $k^{-го}$ порядка вэпса – это двумерная поверхность теневого подпространства, образованная внешними порядкообразующими полусферами негагорки и позилунки $k^{-го}$ порядка, и замыкающей их внутренней цилиндрической поверхностью, центральная ось которой совмещена с теневой продольной осью вэпса (см. рис. 9.1).

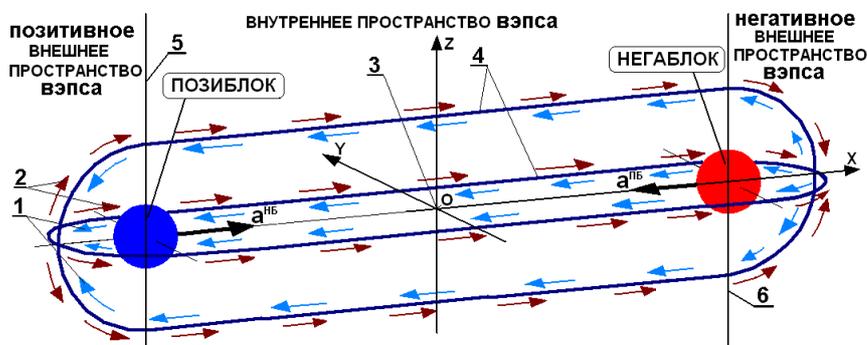


Рисунок 9-1. Вэпс в динамике

где:

- 1 – направление движения лицеронов вдоль образующих ЛБПС вэпса, вызванного процессом сближения вэпсблоков;
- 2 – направление движения тенеронов вдоль образующих ТБПС вэпса, вызванного процессом сближения вэпсблоков;
- 3 – система координат вэпса xuz ;
- 4 – образующие ЛБПС (ТБПС) вэпса $k^{-го}$ порядка;
- 5 – положительная граничная плоскость вэпса – плоскость (параллельна плоскости yOz) разделяющая внутреннее пространство вэпса от его положительного внешнего пространства;
- 6 – отрицательная граничная плоскость вэпса – плоскость (параллельна плоскости yOz) разделяющая внутреннее пространство вэпса от его отрицательного внешнего пространства;
- $a^{пб}$ – направление ускорения негаблока;
- $a^{пб}$ – направление ускорения позиблока;

В разделе 3.4 (см. [1], опр. 3-52) было показано, что вэпсполя ослабевают в направлении движения своих источников и усиливается в противоположном направлении. Следовательно, ускоренные встречные движения негаблока и позиблока вызывают ускоренные эфирпотоки (см. [1], опр. 7-4) вдоль меридианов БПС вэпса. Очевидно, что при отсутствии внешних воздействий на вэпс, эфирпотоки, обусловленные его развитием, остаются ускоренными до момента его аннигиляции. Возникновение эфирпотоков в процессе развития вэпса можно объяснить и тем обстоятельством, что до начала сближения вэпсблоков плотность лицеронов отрицательного внешнего пространства вэпса

больше плотности лицеронов позитивного внешнего пространства (см. [1], раздел 9.1), а плотность тенеронов позитивного внешнего пространства больше плотности тенеронов негативного внешнего пространства. Следовательно, в момент аннигиляции вэпса исчезает (вместе с вэпсом и его вэсполями) эфирный напор (приращения плотностей эфионов) между его позитивным и негативным внешним пространством, т. е. исчезают все искривления Самбатэрпространства обусловленные вэпсом. Поскольку эфирпотoki (магнитные поля), как и прочие поля смещений эфионов, обладают инерцией (см. [1], раздел 5.5), то после аннигиляции вэпса, эфирпотoki, обусловленные его развитием, замедленно продолжают ещё некоторое время, в течение которого происходит процесс излучения ЭМВ. Следовательно, эфирпотoki развития вэпса до его аннигиляции выравнивали искривления Самбатэрпространства, но после аннигиляции вэпса, продолжающиеся по инерции эфирпотoki возбуждают новый концентрационный напор эфионов, противоположный существовавшему до момента аннигиляции концентрационному напору эфионов. Возникшую после аннигиляции вэпса область повышенной объёмной концентрации лицеронов и пониженной объёмной концентрации тенеронов условимся далее называть **позивозбуждением** (см. рис. 9.2 поз. 1). А возникшую после аннигиляции вэпса область повышенной объёмной концентрации тенеронов и пониженной объёмной концентрации лицеронов условимся далее называть **негавозбуждением** (см. рис. 9.2 поз. 7).

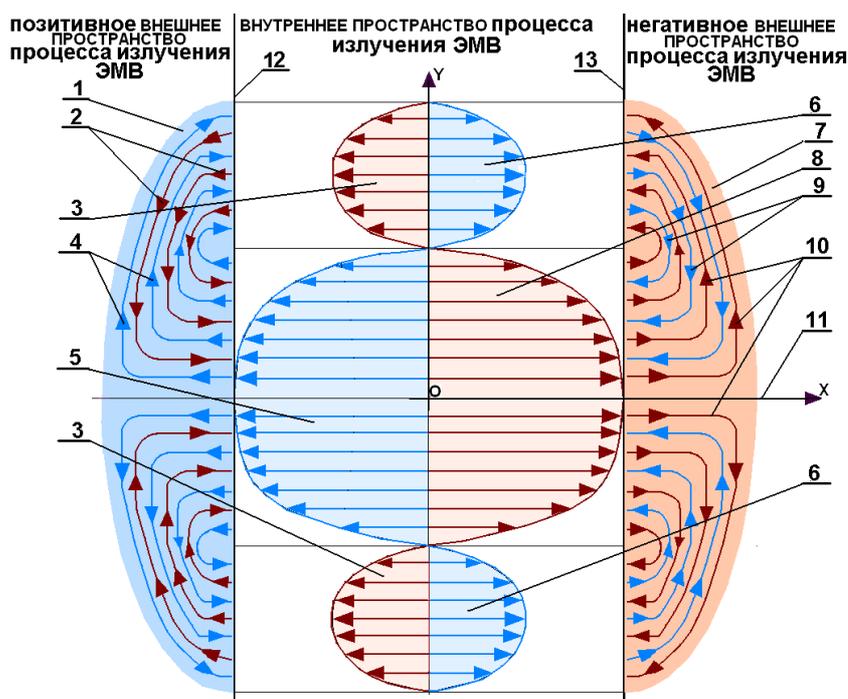


Рисунок 9-2. Схема процесса излучения ЭМВ вэпсом (сечение плоскостью xy)

Где:

- 1 - позивозбуждение (см. опр. 9-5);
- 2 – разворотные (от обратных к прямым) эфирпотoki тенеронов;
- 3 – обратные эфирпотoki тенеронов;
- 4 - разворотные (от прямых к обратным) эфирпотoki лицеронов;
- 5 – прямые эфирпотoki лицеронов;
- 6 - обратные эфирпотoki лицеронов;
- 7 - негавозбуждение (см. опр. 9-6);
- 8 - прямые эфирпотoki тенеронов;
- 9 - разворотные (от обратных к прямым) эфирпотoki лицеронов;
- 10 - разворотные (от прямых к обратным) эфирпотoki тенеронов;

- 11 - система координат вэпса хуз;
- 12 - позитивная граничная плоскость ЭМВ – плоскость (перпендикулярна плоскости рисунка) разделяющая внутреннее пространство ЭМВ от её позитивного внешнего пространства;
- 13 - негативная граничная плоскость ЭМВ – плоскость (перпендикулярна плоскости рисунка) разделяющая внутреннее пространство ЭМВ от её негативного внешнего пространства.

Определение 9-3. Позивозбуждение – область повышенной концентрации лицеронов и пониженной концентрации тенеронов, возникающая во внешнем позитивном пространстве вэпса в окрестности позиблока, сразу после его аннигиляции.

Определение 9-4. Негавозбуждение – область повышенной концентрации тенеронов и пониженной концентрации лицеронов, возникающая во внешнем негативном пространстве вэпса в окрестности негаблока, сразу после его аннигиляции.

Естественно, что позивозбуждение и негавозбуждение являются источниками позитивного и негативного приращения интенсивностей эфирной информации, соответственно возбуждающие в пространстве позитивные и негативные смещения эфиронов (электрические поля). Поскольку эти поля не являются центральными, т. к. у них нет заблокированных центральных источников, то каждому из них, при отсутствии внешних воздействий, ничто не мешает равномерно распределиться в Самбатэрпространстве, со скоростью света. Следовательно, полное отсутствие внешних воздействий на позивозбуждение или негавозбуждение привело бы к его равномерному распределению в пространстве, т. е. к его исчезновению. Но позивозбуждение и негавозбуждение возникают совместно, образуя электрический диполь, т. е. они проявляют внешние воздействия друг на друга. Кроме того на позивозбуждение и негавозбуждение воздействуют прямые и обратные эфирпотoki, обусловленные развитием и аннигиляцией вэпса. Поскольку модуль плеча электрического диполя (позивозбуждение–негавозбуждение), возникшего в момент аннигиляции, предельно мал, то мощность его результирующего поля сконцентрирована в ближайшей окрестности центра вэпса, между его граничными плоскостями.

Далее проанализируем подробнее, наступивший за процессом развития вэпса, процесс излучения ЭМВ.

На протяжении всего процесса развития вэпса, его вэпсблоки ускоренно сближаются, вызывая вдоль образующих БПС вэпса ускоренные эфирпотoki, которые охватывают всё Самбатэрпространство. Поскольку вэпс является электрическим диполем, то мощность этих эфирпотокoв, подобно мощности результирующего поля любого электрического диполя, очень быстро падает с расстоянием от центра диполя.

Поскольку вэпс (ДЭО) обладает частью внутренней энергии Сам-Батэры (см. [1], опр. 1-16, 1-17, 1-20), которая не может бесследно исчезнуть без внешнего воздействия, то вэпс, согласно закону динамизма ДЭО Сам-Батэры (см. [1], опр. 1-21), в конце своего развития должен перейти в некую другую форму. Следовательно, нам остаётся разобраться в том, каков механизм преобразования энергии вэпса в энергию ЭМВ. Очевидно, что в процессе развития вэпса суммарная энергия его вэпсполей падает, а в момент его аннигиляции энергия вэпсполей достигает нулевого значения. Следовательно, энергия вэпсполей вэпса постепенно передается усиливающемуся, в процессе развития вэпса, эфирпотoku (магнитному полю), при этом подавляющая доля энергии вэпса передаётся центральной части эфирпотoka, сосредоточенной в окрестности главной продольной оси вэпса (оси Ox).

Естественно предположить, что, с исчезновением изначальной причины (развивающегося вэпса и его вэпсполей), вызывавшей эфирпотoki вдоль образующих БПС вэпса, эфирпотoki (потoki безинертных эфиронов) должны мгновенно исчезнуть, но это невозможно по следующим причинам:

- Каждый отдельно взятый эфирон эфирпотока, в котором участвует огромное число эфиронов, неподвижен относительно своих ближайших соседей, но как участник эфирпотока совместно с соседями движется относительно Самбатэрсреды. Для того чтобы выйти из эфирпотока эфирону необходимо мгновенно изменить свои отношения с соседями или «договориться» о совместной с ними синхронной остановке, но, ни то, ни другое, невозможно в принципе (см. [1], разделы 2.4 и 2.5).
- Поскольку БПС вэпса разных радиусов соответственно находятся на разных расстояниях от оси вэпса, то приращение интенсивности эфирной информации, вызванное его аннигиляцией, достигает каждую из БПС в разные моменты времени, т. е. эфироны эфирпотока в принципе не могут действовать одновременно «по команде стоп».

Следовательно, эфирпотоки (магнитные поля), как и прочие поля Самбатэрсреды, инертны и обладают энергией. Естественно, что информация об аннигиляции вэпса в первую очередь доходит до ближайших от оси Ox эфирпотоков, далее эта информация охватывает всё более и более отдалённые от оси Ox эфирпотоки. Очевидно, что мощность ближайших от оси Ox эфирпотоков, до которых не дошла информация об аннигиляции вэпса, максимальна, а далее за максимумом мощность эфирпотоков постепенно убывает, с расстоянием от оси Ox , до нуля. С другой стороны, поскольку максимальные эфирпотоки, до которых не дошла информация об аннигиляции вэпса, поддерживают соседние угасающие эфирпотоки, до которых информация об аннигиляции вэпса уже дошла, то текущая мощность угасающих эфирпотоков также убывает с расстоянием от вышеупомянутого максимума в сторону оси Ox (подробнее об эфирпотоках см. [1], раздел 7.3). И поскольку со временем максимум эфирпотока уходит от оси Ox со скоростью света, то эфирпотоки в окрестности оси Ox непрерывно угасают и сравнительно быстро достигают нулевого значения. Следовательно, после аннигиляции вэпса в течение некоторого промежутка времени в окрестности оси Ox продолжают угасающие эфирпотоки, которые приводят к появлению и усилению позивозбуждения в позитивном внешнем пространстве вэпса и негавозбуждения в негативном внешнем пространстве вэпса.

Итак, подытожим вышесказанное. В процессе развития вэпса его вэпсполя постепенно ослабевают, а вдоль образующих его БПС возникают и усиливаются эфирпотоки, которые достигают максимума в момент аннигиляции, а далее продолжают по инерции, но тормозятся усиливающимися позивозбуждением и негавозбуждением. Следовательно, в процессе развития вэпса зарождается и усиливается новый электрический диполь – «позивозбуждение–негавозбуждение» с такой же полярностью что и вэпс, мощность которого достигает максимума через некоторый промежуток времени после аннигиляции, в момент пробоя обратных эфирпотоков.

Естественно, что вызванные позивозбуждением и негавозбуждением концентрационные напоры лицеронов и тенеронов, стремятся вызвать обратные эфирпотоки в лицевом и теневом подпространствах. Но поскольку продолжающиеся по инерции прямые эфирпотоки в лицевом и теневом подпространствах препятствуют этому, то обратные лицевые и теневые эфирпотоки пробиваются на некотором расстоянии от оси Ox , где прямые эфирпотоки достаточно слабы для их пробоя в обратном направлении (см. рис. 9.2 поз. 3 и 6). В том, что противоположно направленные эфирпотоки отталкивают друг друга, можно с лёгкостью убедиться, приближая одноимённые полюса двух магнитов, друг к другу. Естественно, что в момент пробоя обратный эфирпоток минимален, в то же время прямой эфирпоток, подпитывающий позивозбуждение и негавозбуждение, максимален. Следовательно, с момента зарождения обратного эфирпотока его суммарная мощность быстро возрастает, а мощность прямого эфирпотока быстро падает. Очевидно, что через некоторое время, когда суммарные мощности прямого и обратного эфирпотоков сравняются, то процесс заклинивается, т. е. прямой и обратный

эфирпотоки замыкаются в один эфирпоток. Условимся далее называть момент зацикливания эфирпотоков **моментом излучения элементарной электромагнитной волны**.

В момент излучения ЭМВ исчезают позивозбуждение и негавозбуждение, и обусловленный ими концентрационный напор эфионов, а взамен ему возникают разворотные эфирпотоки эфионов (см. рис. 9.2 поз. 2, 4, 9 и 10). Прямой эфирпоток излучаемой ЭМВ изначально примыкает к оси Ox , а её обратный эфирпоток сосредоточен вокруг прямого эфирпотока в виде круговой цилиндрической области.

Со временем, максимумы и минимумы прямого и обратного эфирпотоков непрерывно удаляются от оси Ox со скоростью света, но при этом их относительное положение не меняется. С момента отделения прямого эфирпотока от оси Ox процесс излучения ЭМВ заканчивается и начинается процесс распространения ЭМВ (см. рис. 9.3).

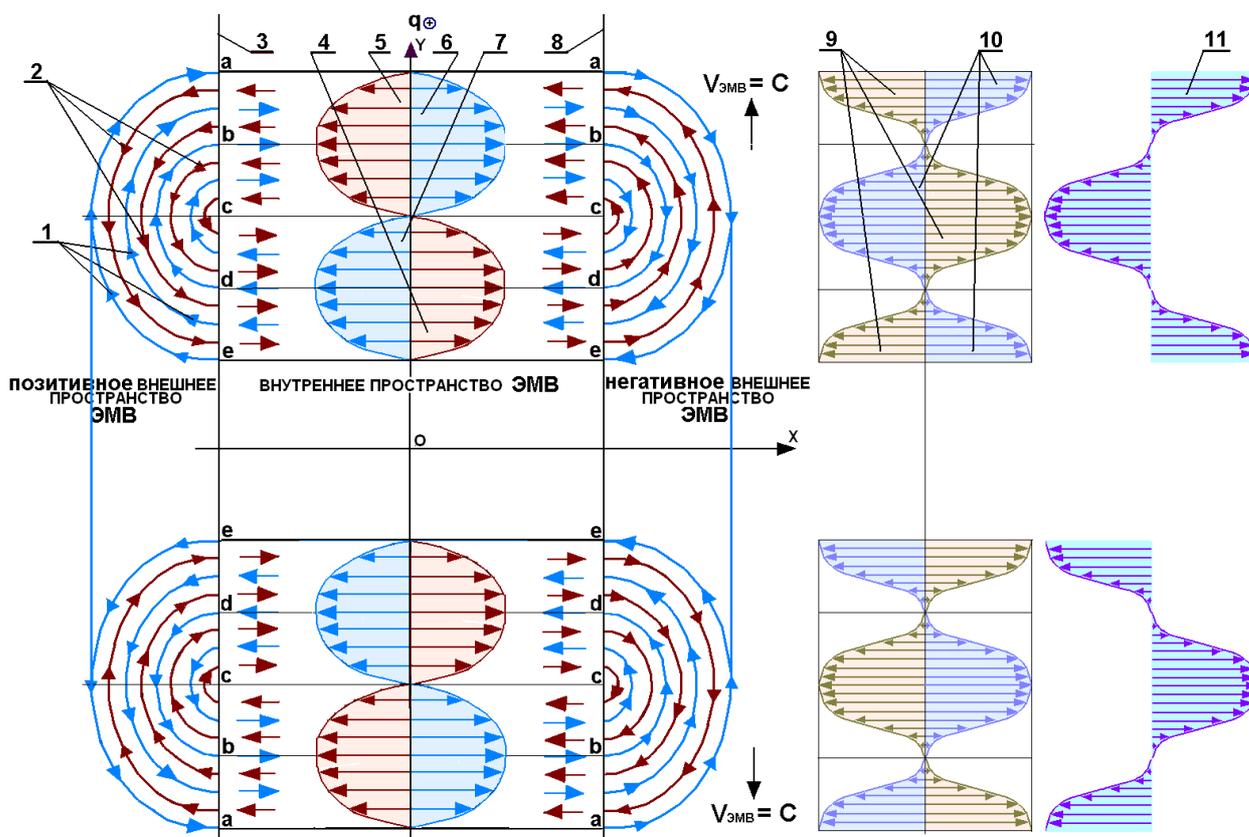


Рисунок 9-3. Сечение процесса распространения ЭМВ координатной плоскостью xOy

где:

- 1 – разворотные эфирпотоки лицеронов ЭМВ;
- 2 – разворотные эфирпотоки тенеронов ЭМВ;
- 3 – положительная граничная плоскость – плоскость (перпендикулярна плоскости рисунка) разделяющая внутреннее пространство ЭМВ от её положительного внешнего пространства;
- 4 – схематический график зависимости величины прямого эфирпотока тенеронов ЭМВ от координаты « y », в текущий момент времени;
- 5 – схематический график зависимости величины обратного эфирпотока тенеронов ЭМВ от координаты « y », в текущий момент времени
- 6 – схематический график зависимости величины обратного эфирпотока лицеронов ЭМВ от координаты « y », в текущий момент времени
- 7 – схематический график зависимости величины прямого эфирпотока лицеронов ЭМВ от координаты « y », в текущий момент времени

- 8 – негативная граничная плоскость – плоскость (перпендикулярная плоскости рисунка) разделяющая внутреннее пространство ЭМВ от её негативного внешнего пространства;
- 9 – схематический график зависимости приращения интенсивности эфирной информации в теневом подпространстве ЭМВ от координаты «у», в текущий момент времени;
- 10 – схематический график зависимости приращения интенсивности эфирной информации в лицевом подпространстве ЭМВ от координаты «у», в текущий момент времени
- 11 – эпюра динамического электрического поля ЭМВ;
- q – пробный позитивный электрический заряд, неподвижный относительно Самбатэрсреды.

Очевидно, что ЭМВ состоит только из одной явной компоненты – замкнутого эфирпотока (магнитного поля), т. е. электрическое поле как таковое в ЭМВ явно не присутствует. Но, как известно, все переменные эфирпотоки (магнитные поля), в том числе и ЭМВ, проявляются (воздействуют на электрические заряды) подобно электрическому полю.

Поскольку диссипация, т. е. потеря энергии эфирпотока на внутреннее трение между эфирами, в Одисфейпространстве практически отсутствует, то потери мощности ЭМВ с расстоянием от источника тоже отсутствует. Но, тем не менее, точечная мощность ЭМВ падает с расстоянием от источника, что связано не с диссипацией, а с её рассеиванием в пространстве, т. е. точечная мощность ЭМВ обратно пропорциональна расстоянию от источника.

Продемонстрируем электрическое действие ЭМВ, например, поведение неподвижного относительно Самбатэрсреды позитивного пробного электрического заряда q^+ , при его пересечении электромагнитной волной (см. рис. 9.3). Как известно из школьной физики переменное (с точки зрения пробного заряда) магнитное поле воздействует на пробный электрический заряд (механизм данного типа воздействий описан в первой части Космометрии (см. [1], раздел 7.4)). Напоминаю, что магнитное поле – это поток лицеронов в некотором направлении с некоторой скоростью и, совмещённый с ним во времени, поток тенеронов в противоположном направлении с той же скоростью. Поскольку излучаемая эфиром эфирная информация равномерно распределена по всему суперспектру направлений его центра, и распространяется со скоростью $C^H \gg C$ относительно источника (см. [1] опр. 2-26, 2-27), то в направлении любого эфирпотока возникает приращение интенсивности переноса эфирной информации. Как говорилось в разделе 3.2 (см. [1]) приращения интенсивности эфирной информации, вызванные центральным источником, образуют центральное поле смещений эфиронов, т. е. центральное электрическое поле. В анализируемой здесь ситуации приращение интенсивности эфирной информации вызваны не центральным источником, а эфирпотоком, но заряд всегда реагирует на пересекающую его эфирную информацию, переменной интенсивности. К постоянному приращению интенсивности эфирной информации (её превышение в некотором направлении над другими направлениями), вызванному постоянным эфирпотоком пробный заряд сравнительно быстро адаптируется и не реагирует на него (подробнее см. [1] раздел 7.4). Следовательно, пересекая заряд q^+ , ЭМВ окажет на него следующий ряд последовательных во времени воздействий:

- Пересекая подвижную область ЭМВ, условно ограниченную цилиндрическими поверхностями a-a и b-b, пробный позитивный заряд испытывает ускоренный эфирпоток лицеронов со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ и ускоренный эфирпоток тенеронов со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ. Следовательно, пересекая данный участок ЭМВ, пробный позитивный заряд испытывает непрерывное приращение интенсивности эфирной информации в лицевом подпространстве со стороны позитивного

внешнего пространства ЭМВ, а в теневом подпространстве со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ. Таким образом, на данном участке траектории ЭМВ, на пробный заряд действует динамическое электрическое поле, направленное от позитивного внешнего пространства ЭМВ к её негативному внешнему пространству. Следовательно, на пробный заряд действует сила Лоренца направленная от позитивного внешнего пространства ЭМВ к её негативному внешнему пространству, т. е. эфирпотки обусловленные Лоренцевым ускорением заряда направлены против возрастающих обратных эфирпотков ЭМВ на данном участке траектории.

- Пересекая подвижную область ЭМВ, ограниченную цилиндрическими поверхностями b-b и c-c, пробный заряд испытывает замедленный эфирпоток лицеронов со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ и замедленный эфирпоток тенеронов со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ. Следовательно, пересекая данный участок ЭМВ, пробный заряд испытывает непрерывное отрицательное приращение интенсивности эфирной информации: в лицевом подпространстве со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ, в теневом подпространстве со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ. Таким образом, на данном участке траектории ЭМВ, на пробный заряд действует динамическое электрическое поле, направленное от негативного внешнего пространства ЭМВ к её позитивному внешнему пространству. Следовательно, на пробный заряд действует сила Лоренца направленная от негативного внешнего пространства ЭМВ к её позитивному внешнему пространству, т. е. эфирпотки обусловленные Лоренцевым ускорением заряда сонаправлены с убывающими обратными эфирпотками ЭМВ на данном участке траектории.
- Пересекая подвижную область ЭМВ, ограниченную цилиндрическими поверхностями c-c и d-d, пробный заряд испытывает ускоренный эфирпоток лицеронов со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ и ускоренный эфирпоток тенеронов со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ. Следовательно, пересекая данный участок ЭМВ, пробный заряд испытывает непрерывное приращение интенсивности эфирной информации в лицевом подпространстве со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ, а в теневом подпространстве со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ. Таким образом, на данном участке траектории ЭМВ, на пробный заряд действует динамическое электрическое поле, направленное от негативного внешнего пространства ЭМВ к её позитивному внешнему пространству. Следовательно, на пробный заряд действует сила Лоренца направленная от негативного внешнего пространства ЭМВ к её позитивному внешнему пространству, т. е. эфирпотки обусловленные Лоренцевым ускорением заряда направлены против возрастающих прямых эфирпотков ЭМВ на данном участке траектории.
- Пересекая подвижную область ЭМВ, ограниченную цилиндрическими поверхностями d-d и e-e, пробный заряд испытывает замедленный эфирпоток лицеронов со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ и замедленный эфирпоток тенеронов со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ. Следовательно, пересекая данный участок ЭМВ, пробный заряд испытывает непрерывное отрицательное приращение интенсивности эфирной информации в лицевом подпространстве со стороны позитивного внешнего пространства ЭМВ, а в теневом подпространстве со стороны негативного внешнего пространства ЭМВ. Таким образом, на данном участке траектории ЭМВ, на пробный заряд действует динамическое электрическое поле, направленное от позитивного внешнего пространства ЭМВ к её негативному внешнему

пространству. Следовательно, на пробный заряд действует сила Лоренца направленная от позитивного внешнего пространства ЭМВ к её негативному внешнему пространству, т. е. эфирпотoki обусловленные Лоренцевым ускорением заряда направлены против убывающих прямых эфирпотокoв ЭМВ на данном участке траектории.

Естественно, что при замене пробного заряда q^+ на q^- , то его ускорения на всех участках траектории ЭМВ поменяют свой знак на противоположный знак.

Из вышесказанного вытекает следующее определение:

Определение 9-5. Элементарная электромагнитная волна (ЭМВ) – это возникший в результате аннигиляции вэпса импульс замкнутого эфирпотoka, перемещающегося в радиальном направлении от центра аннигиляции в пределах внутреннего пространства вэпса со скоростью света, равномерно рассеиваясь по двумерному спектру направлений главной продольной оси вэпса.

Распространяясь в ограниченной граничными плоскостями вэпса, области Самбатэрпространства, ЭМВ остаётся цилиндрической поперечной волной, осью которой является главная продольная ось проаннигилировавшего вэпса (ось Ox). Поскольку расстояние между граничными плоскостями ЭМВ предельно мало (непосредственно перед аннигиляцией вэпса его внутреннее пространство предельно сужено), а эфирпотoki предельно велики, то вызванная аннигиляцией вэпса ЭМВ изначально крайне жёстка, но быстро рассеивается в пространстве.

9-2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ ВОЛНОВЫМИ ЭФИРПОТОКАМИ 3D И 2D ПРОСТРАНСТВ

Мы только что завершили анализ волновых эфирпотокoв Самбатэрпространства, которые нам желательно сравнить с волновыми эфирпотокoками пространства некоторой доступной для нашего наблюдения вселенной.

Единственной доступной для нашего наблюдения вселенной является, базирующаяся на акватории мирового океана планеты Земля 2D вселенная поверхностных волно-вихревых объектов. Очевидно, что эта 2D вселенная, по сравнению с Сам-Батэрой, крайне примитивная, можно сказать, что даже «дикая», но поскольку другой вселенной для сравнения с Сам-Батэрой у нас нет, то остановимся на ней.

Для удобства введём следующие условные названия её компонентов:

Саму акваторию мирового океана, без её волно-вихревых объектов назовём «Аквапространством». Аквапространство совместно с расположенными на нём всевозможными волно-вихревыми объектами назовём «Аквавселенной». Трёхмерную пространствообразующую среду Аквавселенной (см. [1], опр. 1-1), т. е. воду мирового океана назовём «Аквасредой», её приповерхностные 3D молекулы (молекулы воды), являющиеся эфиронами (см. [1], опр. 1-1) Аквапространства, назовём «акваэфиронами». И наконец, поверхностные волны, вихри, солитоны и др. волно-вихревые объекты, возникающие в Аквапространстве, назовём «аквообъектами» Аквавселенной.

Поскольку для нашего сравнительного анализа нас интересуют конкретно волновые эфирпотoki, то остановимся на круговых волнах на поверхности воды, которые условимся далее называть акваволнами.

Как известно акваволны тоже бывают разными, и не все из них подходят для данного анализа. Например, ветровые волны не подходят, т. к. они непрерывно пополняются энергией извне 2D Аквапространства, ветер не только пополняет акваволны энергией, но и срывает саму воду с гребней акваволн.

Поэтому выберем такой способ возбуждения акваволн, при котором они получатся линейными и с минимальным пополнением и диссипацией энергии, что максимально приближает их к ЭМВ.

Пусть над Аквапространством подвешен ударный шар Ш (см. рис. 9.4), удельный вес которого меньше удельного веса Аквасреды «воды». Отпустим его так, чтобы он свободно ударился об Аквапространство «воду», а после удара и отражения от Аквапространства поднимем его вверх над Аквапространством. В результате на Аквапространстве в месте удара возникнет ямка, а вытесненная шаром Аквасреда образует круговое возвышение вокруг ямки. Тогда давление слоя Аквасреды под центром ямки окажется меньше давления того же уровня под круговым возвышением, т. е. Аквасреда этого уровня устремится к центру ямки, в то время как верхний (вытесненный ударным шаром) слой движется по инерции от центра.

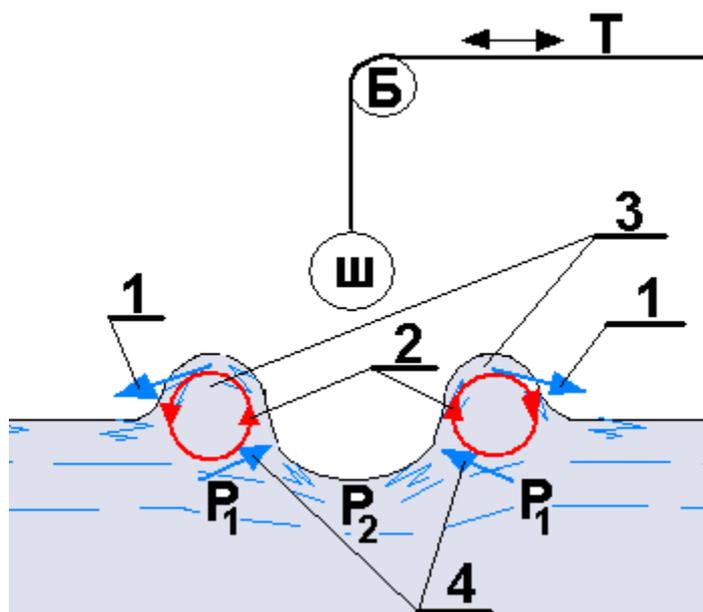


Рисунок 9-4

Где:

- 1 – движение вытесненной шаром Ш массы воды;
- 2 – заикленные волновые эфирпотки;
- 3 – 2D волна, вызванная ударом шара Ш о поверхность воды;
- 4 – движение вытесненной градиентом давления $P_1 - P_2$ воды под гребнем и впадиной 2D волны;
- Ш – ударный шар для возбуждения 2D волны;
- P_1 – гидростатическое давление воды под гребнем 2D волны;
- P_2 – гидростатическое давление воды под впадиной 2D волны;
- Б – блок для опускания и поднятия ударного шара Ш;
- Т – трос.

Итак, верхняя часть гребня акваволны движется от центра ямки, тогда как нижняя его часть движется к её центру, в результате чего эти два встречных потока Аквасреды, которая состоит из молекул воды – акваэфирионов Аквапространства, заикливаются в один круговой поток акваэфирионов (акваэфирпоток).

Следовательно, акваволна это ДЭО Аквапространства, т. е. круговые акваэфирпотки в вертикальной плоскости Самбатэрпространства, т. е. акваволна это торообразный водяной вихрь, равномерно распространяющийся в Аквапространстве по всему 2D спектру направлений центра возбуждения акваволны. Продвигаясь вперёд акваволна вовлекает в свой процесс всё новые и новые поверхностные акваэфирионы в, то время как, оставляет за собой уже успокоившиеся поверхностные акваэфирионы, с

изменившимися отношениями (относительными местоположениями). Например, те акваэфироны, что были внизу, могут оказаться наверху и наоборот.

Но это не значит, что акваволна увлекает за собой акваэфироны, т. к. динамика акваэфирионов, по сути, и есть сама акваволна, а если эту динамику трактовать как вовлечение молекул воды волной, то тогда от акваволны останется одно название. Ведь перемещаясь, фронт акваволны вовлекает в свой круговорот всё новые и новые акваэфироны, а тех, что позади акваволна оставляет «отдыхать после танца».

Итак, подытожим вышесказанное:

Акваволна это зацикленный акваэфирпоток, плоскость которого перпендикулярна Аквапространству, т. е. акваэфирпоток перемешивает эфироны разных слоёв Аквапространства. ЭМВ это зацикленный эфирпоток, плоскость которого параллельна 3D Самбатэрпространству, т. е. эфирпоток не перемешивает эфироны разных слоёв (подпространств) Самбатэрпространства.

Скорость распространения ЭМВ равна скорости распространения эфирной информации (см. [1], раздел 2.3) с учётом времени запаздывания, затраченного на приведение в действие каждого эфирона на пути распространения ЭМВ (в итоге получается скорость света).

Скорость распространения акваволны в Аквапространстве равна скорости света с учётом времени запаздывания, затраченного на приведение в действие каждого акваэфирона на пути распространения акваволны (в итоге получается видимая скорость акваволны).

Очевидно, что энергия акваволны распространяется в Аквапространстве равномерно по всему 2D спектру направлений (см. [1], опр. 2-11) центра возбуждения акваволны, т. е. равномерно по всем направлениям 2D Аквапространства. Хотя, как известно, существуют акваволны, энергия которых распространяется только в одном конкретном направлении, например солитоны.

В отличие от акваволны энергия ЭМВ равномерно распространяется не по всем направлениям Самбатэрпространства, а по 2D спектру направлений центра аннигиляции параллельных экваториальной плоскости вэпса (см. [1], опр. 3-19), а фотон распространяется только в одном направлении.

9.3 ФОТОН

Итак, выше мы исследовали процесс излучения и распространения ЭМВ, которые возникают около нас не часто, и вдобавок рассеиваются в пространстве, т. е. величина их мощности обратно пропорциональна расстоянию от источника. Но абсолютное большинство возникающих около нас ЭМВ излучаются не вэпсами, а атомами вещества и называются «фотонами», которые существенно отличаются от описанных выше ЭМВ. Как известно фотоны не рассеивают свою энергию в пространстве, а распространяясь в одном направлении, полностью сохраняют свою энергию на всём пути своего следования.

Итак, исследуем, в качестве примера, процесс излучения и распространения ЭМВ возбуждённым атомом водорода. О структуре атома водорода достаточно сказано в первой части Космометрии (см. [1], раздел 6.1).

На рисунке 9.5 схематически изображён процесс излучения ЭМВ, вызванный перемещением электрона от дальнего (более удалённого от атомного ядра) электронного уровня ДУ к ближнему (менее удалённому от атомного ядра) электронному уровню БУ. В данном процессе генератором излучения волны является электрический диполь, состоящий из негативного заряда электрона (на рис. 9.5 охвачен жёлтой сеткой) и позитивного заряда в некоторой области ядра (на рис. 9.5 охвачен голубой сеткой). Следовательно, процесс приближения электрона к ядру атома на один или несколько уровней аналогичен процессу развития вэпса (см. рис 9.1). В данном процессе, также как и в процессе развития вэпса, возникают эфирпотoki, при которых лицероны перетекают из негативного внешнего пространства электрического диполя, в его позитивное внешнее

пространство (см. рис. 9.1), а тенероны перетекают в противоположном направлении. В результате межуровневого перехода электрона, в окрестности позитивного заряда (в позитивном внешнем пространстве диполя) возникает позивозбуждение (см. опр. 9-5 и рис. 9.5 поз. 9), а в окрестности электрона в пределах негативного внешнего пространства диполя возникает негавозбуждение (см. опр. 9-6 и рис. 9.5 поз. 6).

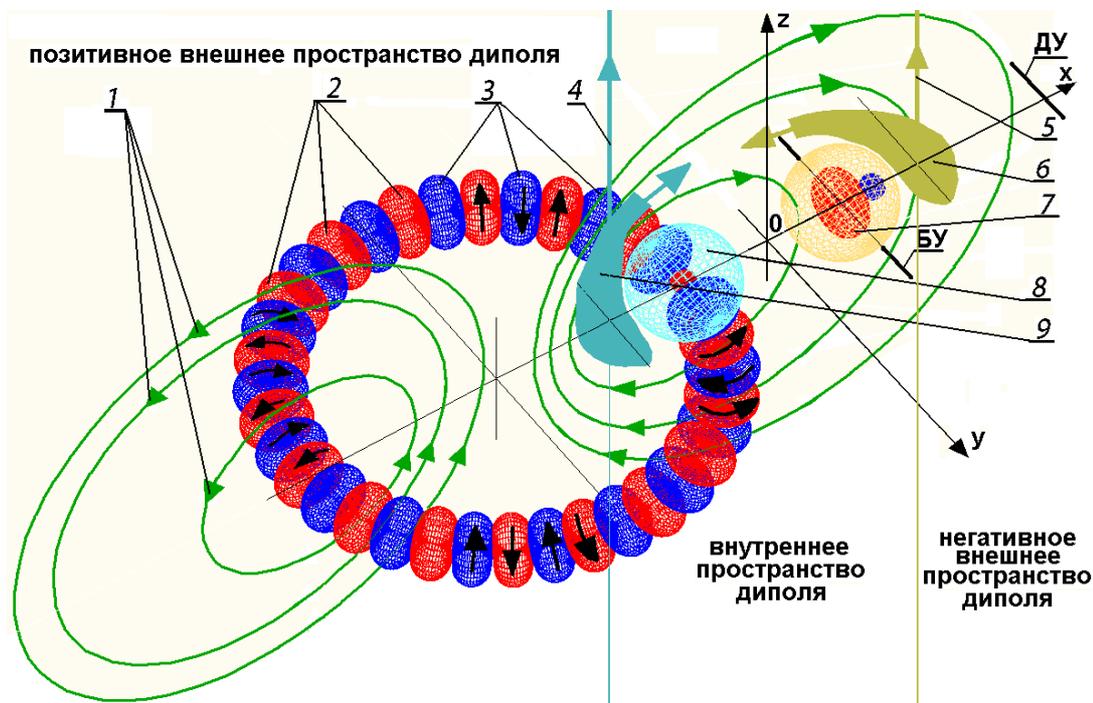


Рисунок 9-5. Излучение фотона

Где:

- 1 – траектории лицевых ядерных (нуклонных) эфирпотоков (подробнее о эфирпотоках см. [1] раздел 7.3) атома водорода. Траектории теневых ядерных эфирпотоков атома водорода направлены в противоположную сторону;
- 2 – нуклонные негасэпсы атома водорода;
- 3 – нуклонные позисэпсы атома водорода;
- 4 – позитивная направляющая ЭМВ – линия пересечения плоскости рисунка с позитивной граничной плоскостью э. диполя, параллельной плоскости xOy ;
- 5 – негативная направляющая ЭМВ – линия пересечения плоскости рисунка с негативной граничной плоскостью э. диполя, параллельной плоскости xOy ;
- 6 – негавозбуждение (см. опр. 9-6);
- 7 – негативный заряд электрического диполя – электрон, на рисунке выделен жёлтой сеткой;
- 8 – позитивный заряд электрического диполя, на рисунке выделен сеткой голубого цвета;
- 9 – позивозбуждение (см. опр. 9-5);
- ДУ – дальний (более удалённый от атомного ядра) стационарный электронный уровень атома водорода;
- БУ – ближний (менее удалённый от атомного ядра) стационарный электронный уровень атома водорода.

Между процессом развития вэпса и процессом междууровневого перехода электрона атома водорода, в свете излучения ЭМВ, существуют следующие существенные различия:

1. вэпсблоки вэпса не обладают массой покоя (гравимассой), т. е. вэпсблоки не обладают гравитационной инерцией. Электроны и ядра атомов обладают

гравимассой (см. [1] раздел 5.4), т. е. они обладают гравитационной инерцией.

2. В момент аннигиляции ээпса расстояние между его граничными плоскостями предельно мало, а эфирпотoki предельно велики. В момент завершения междууровневого перехода электрона, расстояние между зарядами диполя (граничными плоскостями) остаётся сравнительно очень большим, а эфирпотoki сравнительно не большими.
3. Вокруг нуклонсердечника ядра атома водорода (протона) циркулируют нуклонные эфирпотoki (см. рис 9.5 поз. 1), вызванные вращением сэпсблоков вокруг сэпсовой оси нуклона (подробнее о нуклонах см. [1], раздел 6.1). Удельная (на единичную поперечную площадку) мощность нуклонных эфирпоток (нуклонного магнитного поля) предельно высока, т. к. сэпсблоки вращаются вокруг сэпсовой оси нуклона с предельной линейной скоростью, равной скорости света.

Из первого и второго различий следует, что ЭМВ несоизмеримо жёстче фотона.

Из третьего различия следует, что нуклонное магнитное поле ядра препятствует распространению ЭМВ в пространстве между граничными плоскостями электрического диполя по всем параллельным плоскости xOy направлениям, за исключением направления по оси Oz (см. рис. 9.5, рис. 9.6). Следовательно, фотон может распространяться только строго по направлению оси Oz , т. е. положительная и отрицательная граничные плоскости ЭМВ вырождаются в линии, которые условимся называть **положительной направляющей фотона** и **отрицательной направляющей фотона** соответственно (см. рис 9.5 поз. 4 и 5). А ЭМВ, вырождается в линейный волновой импульс (см. рис 9.6), который распространяется параллельно и сонаправлено с осью Oz со скоростью C , а его поперечное сечение в плоскости xOz ограничено минимально возможной толщиной Δx , а в плоскости yOz ограничено положительной и отрицательной направляющими фотона.

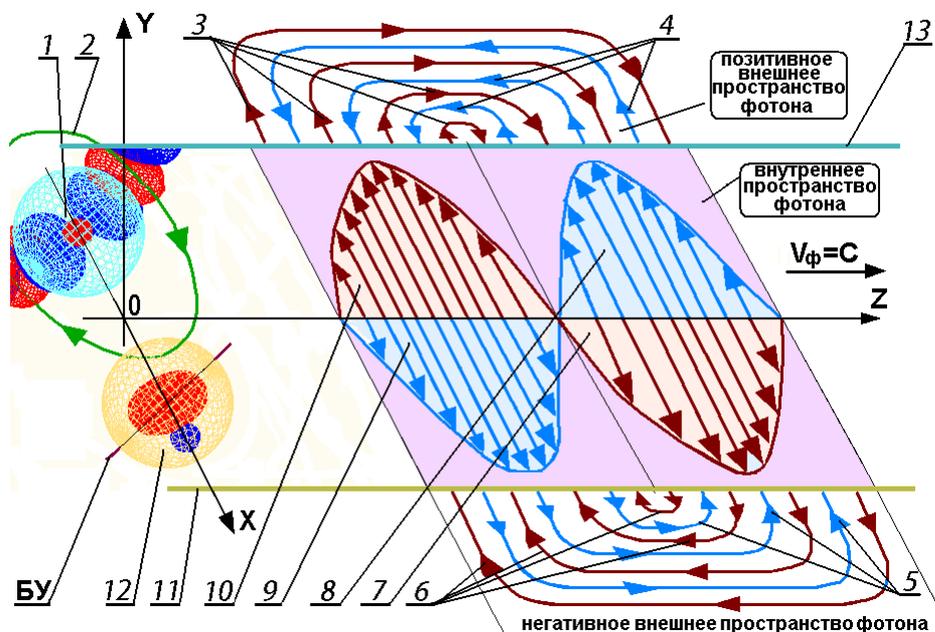


Рисунок 9-6. Распространение фотона

Где:

1 – положительный заряд электрического диполя, на рисунке выделен сеткой голубого цвета;

- 2 – траектории лицевых нуклонных эфирпотоков атома водорода. Траектории теневых нуклонных эфирпотоков атома водорода направлены в противоположную сторону;
- 3 – разворот эфирпотока тенеронов от прямого направления в обратное направление;
- 4 – разворот эфирпотока лицеронов от обратного направления в прямое направление;
- 5 – разворот эфирпотока лицеронов от прямого направления в обратное направление;
- 6 – разворот эфирпотока тенеронов от обратного направления в прямое направление;
- 7 – эпюра обратного эфирпотока тенеронов;
- 8 – эпюра обратного эфирпотока лицеронов;
- 9 – эпюра прямого эфирпотока лицеронов;
- 10 – эпюра обратного эфирпотока тенеронов;
- 11 – негативная направляющая фотона – линия пересечения плоскости рисунка с негативной граничной плоскостью э. диполя, параллельной плоскости xOy ;
- 12 – негативный заряд электрического диполя – электрон, на рисунке выделен жёлтой сеткой;
- 13 – позитивная направляющая фотона – линия пересечения плоскости рисунка с негативной граничной плоскостью э. диполя, параллельной плоскости xOy ;
- БУ – ближний (менее удалённый от атомного ядра) стационарный электронный уровень атома водорода.

Без мощного ядерного магнитного поля атома (тороидального эфирпотока), преобразование излучаемой ЭМВ в фотон, было бы невозможным. Ведь сильное нуклонное магнитное поле концентрирует всю энергию излучаемой электромагнитной волны в одно конкретное направление, тем самым превращает цилиндрическую ЭМВ в линейный волновой импульс.

Из вышесказанного следует, что между ЭМВ и фотоном существует следующее основное отличие:

- Мощность излучённой в процессе аннигиляции вэпса ЭМВ, равномерно распределяется по всему 2D спектру направлений оси Ox (по всем направлениям параллельным плоскости yOz), т. е. мощность ЭМВ в произвольной точке Самбатэрпространства обратно пропорциональна расстоянию между данной точкой и центром аннигиляции.
- Фотон излучается строго по направлению оси Oz и впоследствии распространяется только в этом направлении, следовательно, мощность фотона не зависит от расстояния между фотоном и центром его излучения.

Из вышесказанного следует определение:

Определение 9-6. Фотон – это не рассеивающаяся (с неменяющейся по пути следования мощностью) в пространстве ЭМВ.

Выше мы проанализировали процесс пересечения пробного заряда элементарной электромагнитной волной, и поскольку структура продольного сечения фотона практически не отличается от структуры продольного сечения ЭМВ, то результаты, проведенного выше анализа реакции пробного заряда на пересечение его ЭМВ, подходят и для данного случая. Но поскольку вышеприведенный анализ явно не полный, то попробую ниже его дополнить и пояснить.

Ускоряясь, под воздействием переменного эфирпотока фотона, элементарный пробный заряд вызывает в пространстве свой ускоренный эфирпоток, ускорение которого противоположно ускорению эфирпотока фотона ускоряющего пробный заряд. Если заряд не обладает гравимассой (вэпсблоки), то в процессе его пересечения с фотоном он два

раза меняет своё ускорение на противоположное и, покидая фотон, он приобретает изначальное положение и скорость, т. е. не отнимает энергии у фотона.

Поведение зарядов обладающих гравитационной инерцией (электрон, позитрон и протон) зависит от мощности фотона, которая в свою очередь зависит от периода (волновой частоты) фотона. Если фотон, пересекающий пробный заряд, не обладает достаточной мощностью, то при смене знака текущего эфирпотока фотона, приобретённая до этого кинетическая энергия пробного заряда, недостаточна для его отрыва от фотона. Если фотон высокочастотный (достаточной мощности), то пробный заряд до смены знака ускоряющего его эфирпотока приобретает кинетическую энергию, достаточную для отрыва от фотона, в момент смены знака текущего эфирпотока последнего.

Оторвавшись от фотона, пробный заряд, естественно, не может вернуть фотону приобретённую у него энергию, и, следовательно, уносит её с собой. Если же энергия фотона недостаточна для разгона пробного заряда до возможности его отрыва, то пробный заряд проходит все участки траектории его пересечения с фотоном (см. рис. 9.3), а на финальном этапе возвращает фотону, приобретённую ранее у него энергию. Возможен и такой вариант, когда атомный электрон, в конце участка траектории расположенного между цилиндрическими поверхностями a-a и b-b (см. рис. 9.3), не отрываясь от фотона, переходит на более удалённый от ядра электронный уровень и остаётся там. Естественно, что и в этом случае электрон возвращает фотону не всю приобретённую ранее у фотона энергию.

Тут следует сказать, что электрон, возвращая фотону принятую ранее от него энергию, по сути, рождает новый фотон, направление и фаза которого зависят от направления ядерного (нуклонного) эфирпотока и отношений между атомами, т. е. фотон может поглощаться, отражаться или преломляться.

Теперь попробуем разобраться, почему энергия (мощность) фотона пропорциональна его частоте, хотя правильнее было бы говорить не о частоте, а о длине фотона, т. к. фотон это единичный (циклически не повторяющийся) линейный волновой импульс. Напомню, что фотон возникает в результате перехода электрона из более удалённого от ядра уровня (ДУ) к менее удалённому от ядра уровню (БУ).

Определим хотя бы ориентировочную зависимость мощности фотона от радиального расстояния ДУ и БУ от ядра атома, и от расстояния между самими ДУ и БУ. Очевидно, что мощность фотона равна межуровневой разности потенциалов электрона, которую определим следующим образом:

$$\mathcal{E}_{\text{ду}} = \frac{kq_+q_-}{r_{\text{ду}}}; \quad \mathcal{E}_{\text{бу}} = \frac{kq_+q_-}{r_{\text{бу}}}; \quad \mathcal{E}_{\text{ду}} - \mathcal{E}_{\text{бу}} = \frac{kq_+q_-}{r_{\text{ду}}} - \frac{kq_+q_-}{r_{\text{бу}}} = K \frac{r_{\text{бу}} - r_{\text{ду}}}{r_{\text{ду}}r_{\text{бу}}} = -K \frac{\Delta r}{r(r + \Delta r)}$$

где

$\mathcal{E}_{\text{ду}}$ – количественная характеристика (энергия) кривизны Самбатэрпространства, обусловленная атомом, когда его электрон расположен на дальнем уровне ДУ.

$\mathcal{E}_{\text{бу}}$ – количественная характеристика (энергия) кривизны Самбатэрпространства, обусловленная атомом, когда его электрон расположен на ближнем уровне БУ.

$r_{\text{ду}}$ – радиус дальнего уровня;

$r_{\text{бу}}$ – радиус ближнего уровня;

$\Delta r = r_{\text{ду}} - r_{\text{бу}}$ – расстояние между дальним и ближним уровнями;

$K = kq_+q_-$ – коэффициент зарядов;

$\mathcal{E}_{\text{ду}} - \mathcal{E}_{\text{бу}}$ – межуровневая разность потенциалов электрона (мощность фотона).

Следовательно, с ростом расстояния БУ и ДУ от ядра атома мощность фотона падает, а с ростом расстояние между уровнями мощность фотона растёт, но гораздо медленнее, чем она падает с ростом расстояния БУ и ДУ от ядра атома.

Поскольку ускорение электрона при межуровневом переходе обратно пропорционально квадрату его расстояния от положительного заряда ядра, то с ростом расстояния БУ и ДУ от ядра атома период межуровневого перехода электрона увеличивается, т. е. волновая частота фотона уменьшается.

Следовательно, чем ближе межуровневый переход электрона к положительному заряду ядра, тем мощнее и короче излучённый этим переходом фотон.

Итак, мы рассмотрели процесс излучения ЭМВ и фотона при нормальных состояниях материи, но, как известно, в Сам-Батэре случаются естественные и искусственные ситуации, когда материальные объекты пребывают в аномальном (хаотическом) состоянии. Например, как известно, в ускорителях э. ч. при встречном столкновении нуклонов и др. массивных э. ч., движущихся со скоростью близкой к скорости света, в микроскопической области пространства происходит настоящий хаос. В этом хаотическом процессе практически не возможно однозначно предопределить его конечный результат, т. к. он зависит от множества спонтанных промежуточных (неустойчивых э. ч.) результатов.

Как говорилось в шестой главе Космометрии (см. [1], раздел 6.1), при столкновении разноимённых сэпсов, не обладающих достаточной для их аннигиляции кинетической энергией, они образуют бисэпсовое нейтрино и др. мультисэпсы. Но в хаотических процессах пара сближающихся разноимённых сэпсов могут обладать кинетической энергией, достаточной для преодоления силы отталкивания (обусловленной их сэпскранами) и дальнейшего их сближения вплоть до их аннигиляции. Сближение двух разноимённых сэпсов, обладающих достаточной для их аннигиляции кинетической энергией, условимся далее называть **запредельным сближением** (см. рис. 9.7).

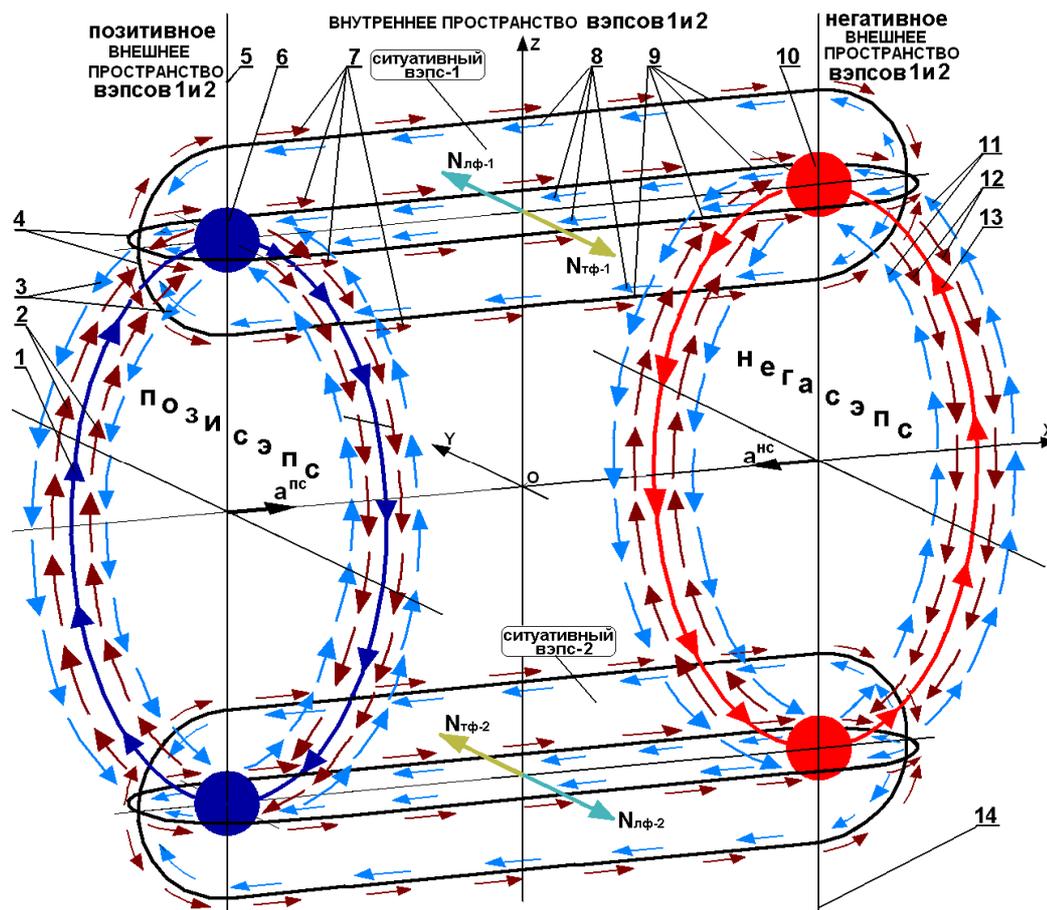


Рисунок 9-7. запредельное сближение разноимённых сэпсов

где:

- 1 – сэпстраектория позисэпса (см. [1], раздел 4.2);
- 2 – эфирпоток тенеронов (теневое магнитное поле) позисэпса;
- 3 – эфирпоток лицеронов (лицевое магнитное поле) позисэпса;

- 4 – образующие лицевой (теневой) сферической части биполярной порядкообразующей сферы $k^{-\tau_0}$ порядка ситуативного вэпса-1 (см. [1], опр. 9-3, 9-4);
- 5 – позитивная граничная плоскость ситуативных вэпсов – плоскость (параллельна плоскости yOz) разделяющая внутреннее пространство ситуативных вэпсов от их позитивного внешнего пространства;
- 6 – сэпсблок позисэпса (см. [1], раздел 4.2);
- 7 – направление движения тенеронов (вдоль образующих теневых биполярных порядкообразующих сфер ситуативного вэпса-1), вызванного процессом сближения сэпсблоков позисэпса и негасэпса;
- 8 – направление движения лицеронов (вдоль образующих лицевых биполярных порядкообразующих сфер ситуативного вэпса-1), вызванного процессом сближения сэпсблоков позисэпса и негасэпса;
- 9 – образующие лицевой (теневой) цилиндрической части биполярной порядкообразующей сферы $k^{-\tau_0}$ порядка ситуативного вэпса-1 (см. [1], опр. 9-3, 9-4);
- 10 – сэпсблок негасэпса (см. [1], раздел 4.2);
- 11 – эфирпоток лицеронов (лицевое магнитное поле) негасэпса;
- 12 – эфирпоток тенеронов (теневое магнитное поле) негасэпса;
- 14 – негативная граничная плоскость ситуативных вэпсов – плоскость (параллельна плоскости yOz) разделяющая внутреннее пространство ситуативных вэпсов от их негативного внешнего пространства;
- 13 – сэпстраектория негасэпса (см. [1], раздел 4.2);
- $N_{\text{лф-1}}$ – направление распространения лицевой стороны (половины) фотона излучённого в результате аннигиляции вэпсблоков ситуативного вэпса-1
- $N_{\text{тф-1}}$ – направление распространения теневой стороны (половины) фотона излучённого в результате аннигиляции вэпсблоков ситуативного вэпса-1
- $N_{\text{лф-2}}$ – направление распространения лицевой стороны (половины) фотона излучённого в результате аннигиляции вэпсблоков ситуативного вэпса-2
- $N_{\text{тф-2}}$ – направление распространения теневой стороны (половины) фотона излучённого в результате аннигиляции вэпсблоков ситуативного вэпса-2

Следовательно, при запредельном сближении разноимённых сэпсов ситуативные вэпсы №1 и №2 аннигилируют, излучая при этом две ЭМВ (по одной на каждого из них). Поскольку вероятнее всего, что эфирпоток аннигилирующих сэпсов сонаправлены, то результирующий эфирпоток переформирует ЭМВ в фотоны, каждый из которых распадается на убегающие друг от друга в противоположные стороны лицевой и теневой полужетон (см. рис. 9.8, направления $N_{\text{лф-1}}$, $N_{\text{тф-1}}$, $N_{\text{лф-2}}$, $N_{\text{тф-2}}$). Здесь предполагается, что магнитные поля сближающихся разноимённых сэпсов сонаправлены, т. к. в случае их противоположной направленности один из сэпсов повернётся на 180 градусов, точно также как это делают обычные магниты при их сближении одноимёнными полюсами. Следовательно, непосредственно перед моментом аннигиляции магнитные поля (эфирпоток) сближающихся сэпсов сонаправлены, а их сэпстраектории направлены противоположно друг другу, т. е. суперпозиция магнитных полей сближающихся сэпсов превращает излучаемые ими цилиндрические ЭМВ в линейные волновые импульсы (фотоны). Очевидно, что при этом лицевые и теневые «половинки» ($N_{\text{лф-1}}$, $N_{\text{тф-1}}$ и $N_{\text{лф-2}}$, $N_{\text{тф-2}}$) излучаемых фотонов разбегаются в противоположные стороны, т. е. $N_{\text{лф-1}}$ и $N_{\text{тф-2}}$ излучаются в направлении от читателя (см. рис. 9.8) и расположены на предельно малом расстоянии друг от друга, а $N_{\text{тф-1}}$ и $N_{\text{лф-2}}$ излучаются в противоположном направлении (к читателю) и также расположены на предельно малом расстоянии друг от друга.

Согласно закону динамизма ДЭО (см. [1], опр. 1-21) сонаправленные лицевые и теневые половинки разных фотонов ($N_{\text{лф-1}}$, $N_{\text{тф-2}}$ и $N_{\text{тф-1}}$, $N_{\text{лф-2}}$), через предельно малый

промежуток времени совмещаются в пространстве, образуя при этом два полноценных фотона, распространяющихся в противоположные стороны.

В случае, когда запредельно сближающиеся разноимённые сэпсы содержат по одному фиксированному взэпблоку (см. [1], рис. 4.11 и 4.12), т. е. являются электроном и позитроном, то при их аннигиляции кроме вышеупомянутых двух фотонов излучается одна цилиндрическая ЭМВ. Цилиндрическая ЭМВ является продуктом аннигиляции между фиксированным позиблоком электрона и фиксированным негаблоком позитрона, в окрестности которых магнитные поля (эфирпотоки) отсутствуют, точнее незначительны. Если сближающиеся электрон и позитрон не обладают достаточной для полной аннигиляции кинетической энергией, то вероятнее всего что произойдёт частичная аннигиляция, продуктами которой являются одна цилиндрическая ЭМВ и одно бисэпсовое нейтрино (см. [1], рис. 6.1).

9-3 ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ НА ПЛОТНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Прежде чем приступить к анализу влияния физических полей Самбатэрпространства на его плотность определим следующие фундаментальные понятия:

Определение 9-7. Физические точки (физточки) Самбатэрпространства – это эфирыны Самбатэрпространства (см. [1], опр. 2-1). Поскольку эфирыны являются полными эфирынокрестностями Самбатэрпространства (см. [1], примеч. 2-4), то физточки можно определить и как полные эфирынокрестности Самбатэрпространства.

Следовательно, множества физточек лицевого, теневого и хвостовых подпространств образуют гранецентрированные кубические решетки соответственно (см. [1], опр. 2-21, рис. 2.2 и примеч. 2-1) и поскольку Самбатэрпространство и все его подпространства замкнуты, то они образованы конечным числом эфирынов, которые в принципе можно посчитать.

Между двумя произвольными смежными физточками Самбатэрпространства существует множество физточек Одисфейпространства, в свою очередь, между двумя произвольными смежными физточками Одисфейпространства существует множество физточек 5D пространства и т. д.

Как сказано в определениях 2-1 и 2-2 Космометрии эфирынами Самбатэрпространства являются 4D молекулы Самбатэрсреды – 4D объекта Одис-Феи. Мы также условились считать, что Самбатэрсреда имеет форму 4D шара. Самбатэрпространство образуют не все 4D молекулы Самбатэрсреды, а только некоторое относительно небольшое количество приповерхностных 3D слоёв 4D молекул Самбатэрсреды, каждый из которых образует своё 3D подпространство.

Введём следующее определение понятия плотности Самбатэрсреды:

Определение 9-8. Плотность Самбатэрсреды – количество 4D молекул Самбатэрсреды, занимающих единичный 4D объём Одисфейпространства.

Для отдельных 3D слоёв 4D молекул Самбатэрсреды, плотностью Самбатэрсреды будем называть количество 4D молекул Самбатэрсреды, занимающих единичный 3D объём данного 3D слоя.

В любом случае прямое обнаружение и измерение изменений плотности Самбатэрсреды возможно только со стороны Одисфейпространства (4D существами), но ниже будет показано, что косвенные проявления градиента плотности Самбатэрсреды возможны и со стороны Самбатэрпространства (3D существами).

Для удобства условимся далее называть (повторяю, **чисто условно**) плотность Самбатэрсреды **плотностью Самбатэрпространства**.

Примечание 9-1. Плотность тривиального Самбатэрпространства одинакова во всех его точках и не зависит от времени, а плотность нетривиального Самбатэрпространства зависит от места и времени (см. [1], опр. 1-13 и 1-15).

Проанализируем, далее, как влияют на плотность Самбатэрпространства элементарные электрические и гравитационные поля. Пусть в некоторой точке i Самбатэрпространства находится негаблок–источник негалунполя в лицевом подпространстве, и негагорполя (см. [1], опр. 3-32 и 3-34) в теневом подпространстве. Для анализа выберем область Самбатэрпространства, ограниченную порядкообразующими сферами (см. [1], опр. 1-8, 1-9, 1-10 и 1-11) центра i радиусом R и $R+r$ (физточки этих сфер также принадлежат выбранной области). Условимся, что количество эфиронов данной области не зависит от её внутренних эфирных отношений. Например, в случае нетривиального (динамического) Самбатэрпространства (см. [1], опр. 1-14) эфироны неоднократно смещаются в ту или иную сторону (даже возможна их взаимозаменяемость, как в магнитном поле), но мы уславливаемся, что на порядкообразующей сфере всегда лежат только те эфироны, которые она содержала бы и в тривиальном Самбатэрпространстве. Следовательно, радиус порядкообразующих сфер, с точки зрения Одисфейпространства, не постоянен (вибрирует) как во времени, так и в спектрах направлений центров этих сфер (см. [1], опр. 2-11 и 2-12), а сами порядкообразующие сферы испытывают импульсивные искажения, но эти искривления Самбатэрпространства мы можем обнаруживать только косвенно. Из вышесказанного следует, что количество эфиронов области, ограниченной двумя порядкообразующими сферами R и $R+r$ центра эфирона i , не зависит от присутствия или отсутствия источника центрального поля в точке i (или других ДЭО). Следовательно, приращение плотности лицеронов (тенеронов) анализируемой лицевой (теневой) 3D области Самбатэрсреды, ограниченной порядкообразующими сферами R и $R+r$, зависит только от, обусловленного негалунполем (негагорполем), приращением её объёма, которое определяются следующим выражением:

$$d\bar{v}_{нб} = \frac{4\pi}{3} \left\{ \left[R+r - \frac{M_{нб}}{4K_{лз}\pi^2(R+r)^2} \right]^3 - \left(R - \frac{M_{нб}}{4K_{лз}\pi^2 R^2} \right)^3 \right\} - \frac{4\pi}{3} [(R+r)^3 - R^3]$$

где:

$d\bar{v}_{нб}$ – приращение объёма данной области, вызванное появлением негаблока в точке i ;

$M_{нб}=\text{const}$ – мощность негаблока или негаблока (см. [1], опр. 3-6, 3-7), а для гравиполя мощность простого гравитона (см. [1], опр. 5-14);

$R>r_0$ – радиус внутренней порядкообразующей сферы центра источника поля (внутренней границы выбранной области);

r_0 – квант расстояния (см. [1], опр. 3-49);

$R+r$ – радиус внешней порядкообразующей сферы центра источника поля (внешней границы выбранной области).

$r \gg r_0$ – разность между радиусами внешней и внутренней границами выбранной области.

После замены дроби $M_{нб}/4K_{лз}\pi^2$ в данном выражении на произведение ER^2 , где: E – модуль абсолютного смещения лицеронов ближней порядкообразующей сферы центра источника поля, и преобразования провой части выражения, получаем:

$$d\bar{v}_{нб} = - \frac{4\pi E^2 r (3R^2 + 3Rr + r^2) (3R^6 + 9R^5 r - 2ER^5 + 9R^4 r^2 - 3ER^4 r + 3R^3 r^3 - 3ER^3 r^2 - ER^2 r^3)}{3R^2 (R+r)}$$

Очевидно, что знаменатель, а также первый и второй множители числителя всегда положительны, следовательно, знак правой части выражения равен знаку функции:

$$f(r) = 3R^6 + 9R^5 r - 2ER^5 + 9R^4 r^2 - 3ER^4 r + 3R^3 r^3 - 3ER^3 r^2 - ER^2 r^3$$

Исследуем функцию $f(r)$

1. если $r=R$, то тогда $f(r)=24R^6-9ER^5$, поскольку для элементарных зарядов и гравитонов $E<r_0$, т. е. $E<1$, то $f(r)>0$.

2. если $r<R$, то тогда $3R^6>ER^2r^3$; $9R^5r>2ER^5$; $9R^4r^2>3ER^4r$; $3R^3r^3>3ER^3r^2$, следовательно, $f(r)>0$.

3. если $r>R$, то тогда: $3R^6>2ER^5$; $9R^5r>3ER^4r$; $9R^4r^2>3ER^3r^2$; $3R^3r^3>ER^2r^3$, следовательно, $f(r)>0$.

Следовательно, приращение объёма исследуемой области лицевого подпространства, вызванное появлением неаглоба в точке i отрицательно, т. е. имеет место увеличение объёмной концентрации лицеронов (лицевое подпространство сжимается).

Аналогичный анализ теневого подпространства охваченного неаглобом (см. [1], раздел 3.2) показывает, что неаглобом уменьшает объёмную концентрацию тенеронов (теневое подпространство расширяется).

Анализ позиблока показывает, что позигорполе расширяет лицевое подпространство, а позилунполе сжимает теневое подпространство.

Следовательно, элементарное позитивное электрическое поле растягивает лицевое подпространство и сжимает теневое подпространство, а элементарное негативное электрическое поле сжимает лицевое подпространство и растягивает теневое подпространство. Поскольку неэлементарные электрические поля являются суперпозицией элементарных полей, то позитивные неэлементарные поля растягивают лицевое подпространство и сжимают теневое подпространство. А негативные неэлементарные электрические поля сжимают лицевое подпространство и растягивают теневое подпространство. Следовательно, одновременное сжатие одного из головных подпространств и растяжение второго из них компенсируют друг друга, и в результате электрические поля не сжимают и не растягивают Самбатэрпространство в целом, т. е. общая плотность эфиронов охваченной электрическими полями области Самбатэрпространства не зависит от этих полей.

Аналогичный анализ гравитационных полей показывает, что гравиполя сжимают все головные и хвостовые подпространства пропорционально мощности их гравиполей соответственно. Следовательно, гравиполя сжимают Самбатэрпространство, но поскольку мощности гравиполей головных и хвостовых подпространств падает с ростом их порядкового номера (см. [1], гл. 5), то и степень их сжатия соответственно падает. В разделе 2.5 Космометрии сказано, что скорость протекания всех процессов в Сам-Батэре обратно пропорциональна плотности Самбатэрпространства или некоторой его области (см. [1], (2-11)^а), в которой эти процессы протекают.

Из вышесказанного следует, что скорость изменения и распространения динамических эфирных отношений в Сам-Батэре обратно пропорциональна мощности гравиполя, охватывающего эти ДЭО, убедительным экспериментальным подтверждением этому служит падение скорости света в окрестности массивных небесных тел.

Примечание 9-2. поскольку материя Одис-Феи принципиально отличается от материи Сам-Батэры, то, естественно, что в Одис-Фее нет электромагнетизма, в том числе и света. Но в Одис-Фее есть некая субстанция, распространяющаяся в тривиальном (свободном от объектов Одис-Феи) Одисфейпространстве со скоростью значительно превышающей скорость света в Самбатэрпространстве. В свете Космометрии эту субстанцию Одис-Феи я назвал эфирной информацией, которая проявляется в Сам-Батэре в ином качестве – в качестве ЭМВ (света). Действительно, на пути распространения эфирной информации в Самбатэрсреде (см. [1], опр. 2-1) расположены эфироны Самбатэрпространства (4D объекты Одис-Феи), которые поглощают всю падающую на них эфирную информацию, а затем выпускают ее, равномерно распределяя по суперспектрам направлений своих центров (см. [1], раздел 2.5). Следовательно, эфирная информация, распространяясь не в пустом Одисфейпространстве, а заполненном

эфиронами Самбатэрпространства, перераспределяется по их суперспектрам направлений. Естественно, что на перераспределение эфирной информации эфиронами Самбатэрпространства затрачивается некоторое время, которое сокращает скорость эфирной информации в Самбатэрпространстве до скорости света.

Следовательно, скорость света зависит от плотности Самбатэрпространства, т. е. от количества посредников на пути следования эфирной информации (чем больше посредников, тем меньше скорость света). О том, что скорость протекания всех процессов в Сам-Батэре обратно пропорциональна плотности Самбатэрпространства, мы уже говорили в разделе 2.5 Космометрии (см. [1], (2-11)^а).

Вышесказанное неопровержимо подтверждается следующим фактом:

Экспериментально обнаружено, что траектория света искривляется вблизи массивных небесных тел, например, вблизи Солнца.

Рассмотрим, например, траекторию звёздных световых фотонов в окрестности Солнца. Проследим за перемещением фронта световых ЭМВ, излучённых некоторой звездой, из положения **ab** в положение **cd** (см. рис 9.8, где **ab** и **cd** линии пересечения фронта ЭМВ с плоскостью рисунка). Очевидно, что в течение некоторого промежутка времени $\Delta t = t_1 - t_2$, фронт ЭМВ переместится из положения **ab** в положение **cd**. Как говорилось в разделе 9.1, гравитационное поле уплотняет Самбатэрпространство, т. е. средняя объёмная плотность физточек (эфиронов) Самбатэрпространства вдоль луча **ac** больше таковой вдоль луча **bd**. Следовательно, скорость света вдоль линии **ac** меньше скорости света вдоль линии **bd**, а это значит, что анализируемый фронт световой волны, по мере продвижения в окрестности Солнца, должен непрерывно поворачиваться к центру Солнца, т. е. огибать его, что и наблюдается при экспериментах.

Из вышесказанного следует, что вызываемый гравиполем градиент плотности Самбатэрпространства косвенно проявляется в виде искривления траектории фотонов.

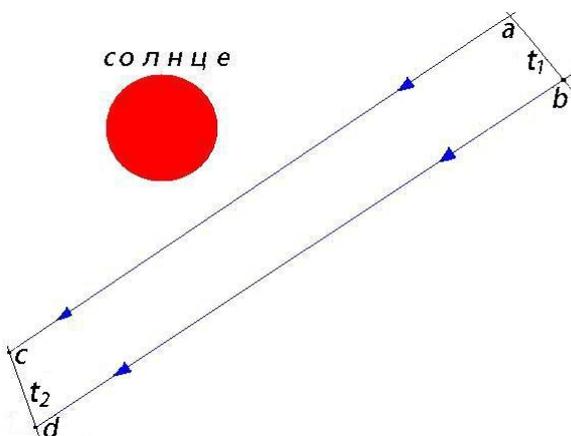


Рисунок 9-8

ЛИТЕРАТУРА:

[1] – И.Д.Станев, «Космометрия»,

Часть первая – «о мирозданиях, пространствах и элементарных частицах».

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12401.html>

или <http://technic.itizdat.ru/docs/seps000/FIL13563526980N929957001/>